PAT-NO:

JP403285208A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03285208 A

TITLE:

CONDUCTIVE PASTE

PUBN-DATE:

December 16, 1991

INVENTOR-INFORMATION: NAME SEGAWA, SHIGETOSHI BABA, YASUYUKI FUKUNAGA, YASUKAZU OTANI, HIROYUKI ARISUE, KAZUO NAKATANI, SEIICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP02086564

APPL-DATE:

March 30, 1990

INT-CL (IPC): H01B001/20, H05K001/09 , C08L029/14

US-CL-CURRENT: 524/431

# ABSTRACT:

PURPOSE: To make the sintering shrinkage timing of conductive paste agree with that of the material of a substrate to increase reliability by a method wherein conductive paste has an inorganic component containing glass frit and MgO powder in addition to CuO powder and an organic vehicle component made up of at least an organic binder and a solvent.

CONSTITUTION: This conductive paste has an organic vehicle component made up of an inorganic component containing CuO powder at 87.0-99.4wt.%, glass frit at 0.5-10.0wt.% and MgO powder at 0.1-3.0wt.%, and an organic vehicle component made up of at least an organic binder and a solvent. Moreover, this conductive paste has an inorganic component containing CuO powder at 67.0-96.4wt.%, MgO powder at 0.1-3.0wt.% and at least one or more of A1<SB>2</SB>O<SB>3</SB>, SnO<SB>2</SB>, TiO<SB>2</SB> and MnO<SB>2</SB> at 3.0-20.0wt.%, and an organic vehicle component made up of at least an organic binder and a solvent. The amount of addition of MgO is 0.5-3wt.%. It is thereby possible to make the sintering shrinkage timing and the contraction volume of the conductive paste agree with those of the material of a substrate.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO&Japio

# ⑩ 日本国特許庁(JP)

## ① 特許出願公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-285208

(9)	nt. Cl	. *		識別記	子	庁内整理番号	❸公開	平成3年(199	1)12月16日
	01 B 05 K 08 L	1/: 1/i 29/	09	LHA	A A	7244-5G 8727-4E 6904-4 J			
			.,.			審査請求	未請求 請	求項の数 2	(全5頁)
9発9	明の名	练	導電性	ベースト					
				②特	顧	平2-86564			
				魯出	顧	平 2 (1990) 3 月30日			
個発	明:	者	瀬ノ	1 茂	俊	香川県高松市寿町 2 <sup>-</sup> 社内	丁目 2 番10号	松下寿電子	工業株式会
@発	明	者	馬与	康	行	香川県高松市寿町 2 <sup>-</sup> 社内	丁目 2 番 10号	松下寿電子	工業株式会
個発	明	者	福力	〈 靖	-	香川県高松市寿町 2 7 社内	丁目 2番10号	松下寿電子	工業株式会
個発	明	皆	大 名	博	之	大阪府門真市大字門。	11006番地	松下電器産業	朱式会社内
@発	明	皆	有才	₹ -	夫	大阪府門真市大字門。	其1006番地	松下電器産業	朱式会社内

外1名

3B 5m ±

松下電器産業株式会社

弁理士 栗野 重孝

1、発明の名称

導電性 ベースト

の出 頭 人

70代 理 人

- 2、特許請求の範囲
- (I) C u O 粉末 8 7.0 ~ 9 9.4 重量%に、ガラスフリット 0.5 ~ 1 0.0 重量%と、M g O 粉末 0.1 ~ 3.0 重量% 6 育した無機成分と、少なくとも有機パインダと溶剤よりなる有機ビヒクル成分を増えたことを特徴とする薄電性ペースト。
- (2) 、C u O 粉末 6 7.0 ~ 9 6.4 重量%に、ガラスフリット 0.5 ~ 1 0.0 重量%と、M g O 粉末 0.1 ~ 3.0 重量%、さらに A £ 2 O 3.5 n O 2. T i O 2. M n O 2.0 内少なくとも 1 種以上を 3.0 ~ 2 0.0 重量%含有した無機成分と、少なくとも有機パインダと溶剤よりなる有機ビヒクル成分を備えたことを特徴とする導電性ペースト。
- 3、発明の詳細な説明 産業上の利用分野

本発明は、回路基板用導電性ペーストに関する ものであり、特に低温焼成セラミック多層配鉄基板 (以下MLCと略す。) の電極及びピアネール 用電極材料として使用される導電ペーストに関する。

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

#### 従来の技術

大阪府門真市大字門真1006番地

事体材料に注目すると、Au, Ag/Pdは空気中で焼成できる反面、貴金属であるためコストが高い。一方、W, Ni, Cuは、卑金属で安価であるが、焼成雰囲気を運元雰囲気か中性の雰囲気で行う必要がある。又、W, Moでは、1500℃以上の高温焼成となる。きらに信頼性の面から Au では、半田 食われが問題となり、Ag/Pdでは、マイグレーション及び弾体抵抗が高いという問題がある。そこで、安価で電気抵抗が低く、半田付け性の良好な Cuを用いるようになってきた。

例えば、米国特許第4072771号明報報には、Cuベーストの組成、同じく特別的56-93396号公報に開示されている。前者はCu粉にガラスフリットを含有する組成物での構成が記載されている。

しかしCuを使う上でも課題がある。それは、 Cu電極による新電体基質への焼成は、還元もし くは中性雰囲気となり、ペースト中の有機パイン ダの分解除去が困難となるからである。これは、 選素中の酸素濃度が低いた的パインダの分解が起 こらず、カーボンの形で残り、メクライズ性能に 悪影響を及ぼす。逆に酸素濃度が高いと、Cu電 極が酸化され、誘電体中に拡散して電極と気気に 能しなくなる。そのため焼成は、窒素雰囲気中に 若干の酸素をコントロールしながら供給するとして で行われる。そして、残存したカーボンが酸化 と反応して電極層にブリスタを発生させたり、電 極一誘電体間のマッチングを悪くさせる要因とな る。

C + 2 C u O → C O 1 ↑ + 2 C u このように C u ベーストは、有機パインダの使 用に多くの課題を有している。

そこで近年、導体材料の出発原料にCuOを用いる新しいCu電極多層セラミック蒸板の製造方法が開発された。つまりセラミックグリーンシート上にCuO導体組成物によって配鉄パターンを形成し、機層の後、酸化性雰囲気中の熱処理で前記CuO導体組成物、及びセラミックグリーン

シート中の有機残器を無分解する工程と、運元雰囲気中の無処理でCu金属に運元する工程と、運業雰囲気でのセラミック器質の焼成を行う工程とり作製されるという構成を備えたものである。例えば特別取61-26293号公報、米国特許4.795.512号明細書、同じく米国特許4.863.683号明細書に開示されている。このセラミック機層体の製造方法によれば絶謀器の及びベースト中の有機パインダの分解除法が容易となり、かつ良好なCuのメクライズが得られる。

発明が解決しようとする課題

 結収縮タイミングが同一でないために起こると考えられ、又後者は焼結後の収縮率の差、換言すれば焼結後の収縮率の差、換言すれば焼結後の体積差から起こるもの(ミスマッチ)と考えられる。このような現象が起こると、内部電極とピアホール電極の導過不良等の信頼性を著しく低下させるという不都合があった。

本発明は上記課題に継み、焼桔収縮タイミングの高板材料との同一化で信頼性の高い内部電極用 等電性ペーストを提供するものである。 又、焼桔体装をコントロールすることで良好なピアホール 用導電性ペーストをあわせて提供するものである。

課題を解決するための手段

上記課題を解決するために本発明の導電性ベーストは、CuO粉末の他にガラスフリットとMgO粉末を含有した無限成分と、少なくとも有機パインダと溶剤よりなる有機ピヒクル成分よりなる。 又、一方の導電性ベーストはCuO粉末の他にガラスフリットとMgO粉末、さらにAllOo. SnO2、TiO2、MnO2の内少なくとも1種以上を含有した無機成分と、少なくとも有機パイ ングと溶剤よりなる有機ビヒクル成分よりなる。 特に前者の導電性ベーストは内部電極用として通 し、後者はビアホール電極用として適している。

本発明は、セラミック機構体をつくる上で上記した構成のCuOベーストを用いることにより、セラミック材料と良好なマッチング性を得ることができるものである。本発明のCuOベーストは、CuOの他にガラスフリットとMgOを添加すること、もしくはさらにAl2O3、Sn·O2。TiO2、MnO2の内少なくとも1種以上を添加して得られる。本発明の連載性ベーストははセラミック機構体として、主に多層セラミック配験を観明のCuOベーストは、前記の添加物を加える収載のCuOベーストは、前記の添加物を加えるでは、MLCに対して本をことができてuとMLCとの一

本発明の導電性ベーストに含まれる添加物のうち、MgOは種々の検討の結果、Cu粉の焼結性

を阻害する効果のあることを見いだした。つま り、還元工程後のCu粉は基板材料と比べ嫌鉄の タイミングが早過ぎるために隙間が生じたり、セ ラミック層にクラックが生じる原因となっていた が、Mg0を添加することで、基板材料の焼結温 度付近で焼結反応が起こるようになり、本発明の CuO組成物では上記のような問題が起こらな い。この時、MgOの添加量が0.1 賞量%以下 では効果が少なく空洞発生を抑えられない。又3 重量%以上では焼結タイミングが遅すぎ、セラミッ ク層にクラックを発生させる原因となる。よって 望ましくは 0 . 5 ~ 3 % が良い。又、 A ℓ 2 O 3 . SnO<sub>2</sub>. TiO<sub>2</sub>, MnO<sub>2</sub> 等の添加物を同時に 添加することで、電極層の焼結後の体積収縮がセ ラミック基板材料のそれと大差なくなる。その結 果、ピアホール等の電極層で良好なメタライズが 得られかつ良好な性能のピアホールが形成でき る。又、これらの添加物の総添加物量が3貫量% 以下では、電極層の体積収縮を抑えることができ ない。よって、ピアホールとセラミック層との間

敵に空剤ができる。逆に20重量%以上では導体 層の収縮が小さすぎるため、焼結体とのマッチン グ性が悪くなる。又、導体層のインピーチンスが 著しく高くなるので良くない。望ましくは添加物 が10~15重量%が良い。

#### 客旅例

体化に楽している。

以下本発明の一実施例の多層セラミック配線基板について、図面を参照しながら説明する。第 1 図は、本発明の第一の実施例における多層セラミック配線基板の新面図を示すものである。第 1 図において、1 は内部電極、2 は誘電体層、3 はピアホール電後層である。

本発明のセラミック多層基板に使用した材料は、ガラス成分として硼珪酸ガラス (コーニング社製# 7 0 5 9) をセラミック成分としてアルミナ粉末を重量比で 5 0 対 5 0 混合した物を用いた。次に胸配基板材料粉末を無機成分とし、有機パインダとしてポリブチルブチラール可塑剤としてジーローブチルフタレート、溶剤としてトルエンとイソプロビルアルコールの混合液 (3 0 対 7 0

重量比)を第1表の通りの組成で混合しステリー とした。

第1表 誘電体組成。グリーンシート組成

绣 電 体	前紀組成	1 0 0 vt 9
	有機パインダPVB	1 2 *t %
グリーン	可塑剤 DBP	5 v t %
シート	溶剤	
	トルエン/エタノール	50 v t %
	7/3	

このスラリーを充分混合の後、ドクターブレード法で有機フィルム上に造譲し、グリーンシートとした。 乾燥後の腹厚は、約200であった。 このグリーンシートに必要に応じてピアホールを金型に てパンチングする。ピアホールほは、0.2

次に導電性ペーストは、酸化第二解粉(平均粒径3 μm)に接着強度を得るためのガッスフリット 及び各種の添加物を、第2表のような組成で混合した物を用いた。

第2表 酸化銅ペースト無機組成 (wt%)

Ha	CuO	ガラス	NgO	Sn0 <sub>2</sub>	TiO <sub>2</sub>	MnO <sub>2</sub>	A £ 203	インピー ダンス	空洞化	ピアマッ
					,			(m2/10µm)	254775	チング性
1	96. 95	3. 0	0.05					3, 0	×	Δ
2	96.80	3. 0	0. 2					3. 1	0	Δ
3	96. 50	3. 0	0.5					3. 3	0	0
4	96.00	3. 0	1.0					3. 5	0	0
5	94. 00	3. 0	3. 0					18. 2	0	0
6	92.00	3. 0	5. 0					œ	0	×
7	96.40	3.0	0. 1	0.5				3. 0	×	Δ
8	93. 90	3.0	0. 1	3. 0				4. 4	Δ	Δ
9	91.90	3.0	0. 1	5. 0				5. 3	0	0
10	86. 90	3.0	0. 1	10.0				8. 5	0	0
11	76. 90	3.0	0. 1	20.0				20. 4	0	0
12	66. 90	3.0	0. 1	30.0				00	0	×
13	96. 40	3. 0	0. 1		0.5			3. 4	×	Δ
14	93. 90	3. 0	0. 1		3. 0			3. 6	Δ	Δ
15	91.90	3. 0	0.1		5.0			3. 9	0	0
16	86. 90	3.0	0. 1		10.0			5. 8	0	0
17	76. 90	3.0	0. 1		20.0			18. 9	0	0

								インピー		ピアマッ
No	CuO	ガラス	MgO	\$n0₂	TiO,	#n0:	A £ :03	ダンス (mΩ/10μm)	空阀化	チング性
18	66. 90	3. 0	0. 1		30. 0			50. 4	0	×
19	96. 40	3. 0	0. 1			0. 5		3. 1	×	Δ
20	93. 90	3. 0	0. 1			3.0		3. 3	Δ	Δ
21	91.90	3.0	0. 1			5. 0		3.8	0	0
22	86. 90	3.0	0.1			10.0		6.7	0	0
23	76.90	3. 0	0. 1			20. 0		20. 2	0	0
24	66. 90	3. 0	0. 1			30. 0		51. 3	0	×
25	96. 40	3. 0	0.1				0.5	3. 0	×	Δ
26	93. 90	3.0	0.1				3. 0	3. 0	Δ	Δ
27	91. 90	3. 0	0. 1				5.0	3. 5	0	0
28	86, 90	3.0	0. 1				10. 0	8. 7	0	0
29	76. 90	3. 0	0. 1				20.0	18.0	0	0
30	66. 90	3. 0	0. 1				30.0	46. 6	0	×

# 特開平3-285208 (5)

完成したMLC基板の内部電極部のメタライズ性能をシート抵抗値(腰厚10μm換算)で評価した。又、内部電極の空洞化の抑制効果及びピアホールの電極埋設状態を、ピアホールマッチング性として評価した。空洞の評価は、内部電極の鍵

厚に対して空洞部の厚みの比で表した。すなわち、全く空洞が存在しない場合は〇、内部の高端が存在しない場合は〇、内があるは×とした。ピアホールマッチング性の評価では、定量的に表せないのでSEM観察示す。第2数部に及上の結果を第2数部にMg0の添加りに対象がある。又、の添りにないのである。又、Mп02・をが明らかである。とが明らかである。又、Mп02・をが果からでも同様に、ピアホールのマッチング性に効果があることがわかる。特に本実施例のとして特にの内部電極用に適し、、ピアホールの理数用の導電性ベーストとして最適である。

## 発明の効果

以上のように本発明の C u O ベーストは、 C u O の他にガラスフリットと M g O を添加すること、 もしくはさらに A f 2 O 2 , S n O 2 , T i O 2, M n O 2 の内少なくとも 1 種以上を添加すること

で、 基板材料との焼詰収縮タイミング及び収縮体 棟を一致させることができ、 C u と M L C との一 体化に適している。 これにより、より信頼性の高 い C u 内部電極及びピアホールを持つ M L C を提 供するものである。

## 4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例における導電性ベーストを使用して作製したMLCの内部電極ならびにピアホールの断面図、第2図は従来のCuOベーストによるMLCの内部電極ならびにピアホールの断面図である。

1 … … 内部電極、 2 … … 誘電体層、 3 … … ピァホール電極層、 4 … … 空洞部。

代理人の氏名 弁理士 栗野重孝 ほか1名

